智慧財產及商業法院行政判決

112年度行專訴字第30號
民國112年12月7日辯論終結

原　　告　台達電子工業股份有限公司
（DELTA ELECTRONICS INC.）
代　表　人　海英俊
訴訟代理人　彭國洋律師
徐念懷律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　廖承威
訴訟代理人　何立瑋
陳志遠

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國112年4月13日經訴字第11217301740號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　文

一、訴願決定及原處分均撤銷。
二、被告應就第109128366號「波長轉換元件及光源模組」發明專利申請案，作成准予專利之審定。
三、訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月30日施行)第75條第3項規定：本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產行政事件，適用本法修正施行前之規定。因本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，即應適用修正前即110年12月10日公布施行之規定，合先敘明。

貳、實體方面：

一、事實概要：

原告前於109年8月20日以「波長轉換元件及光源模組」向被告申請發明專利，經被告編為第109128366號審查(下稱系爭

案)，不予專利。原告不服，申請再審查，並於111年8月9日提出申請專利範圍修正本。嗣經被告依前揭修正本審查後，認系爭案有違專利法第22條第2項規定，以111年11月9日(111)智專三(二)04201字第11121112260號專利再審查核駁審定書為「不予專利」處分(下稱原處分)。原告提起訴願，經經濟部於112年4月13日以經訴字第11217301740號決定駁回(下稱訴願決定)後，原告不服原處分及訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張及聲明：

(一)原處分及訴願決定錯誤比對如附表之引證與系爭案兩者之元件：

依引證1說明書第11頁第8至9行揭露「散熱層3係外徑與第1多孔質陶瓷層1大致相同且為同心之環狀」可知，引證1散熱層3之外型根本非葉片，而係「環狀基板」，且對於所屬技術領域中具有通常知識者，「葉片」的通常性解讀不會是一「環狀」且「層狀」的結構，因此認定引證1之「散熱層3」為「葉片」結構，明顯不符所屬技術領域中具有通常知識者的通常知識。而依系爭案說明書第〔0025〕段明確揭露：「通孔性葉片123的整體幾何形狀可以經由裁切、排列或拼湊等方式形成葉片形狀或不為葉片形狀，例如複數條狀的散射形排列方式」，且觀系爭案的第1圖至第3圖皆可見通孔性葉片的一具體實施例為包含複數條狀在基板底面上散射形排列的結構。另觀引證1說明書第11頁第11至13行所揭露內容，可知引證1之散熱層3功能在於導走第1陶瓷層1由螢光體層2傳導而來的熱，其實際上係用於傳導熱之「環狀基板」，並非作用產生氣流之「葉片」。由此可知，引證1之散熱層3不論在外型或功能上，明顯為利用「傳導熱」方式之「環狀基板」，而非利用「對流」方式產生氣流之「葉片」。是以，原處分執意將「引證1之散熱層3」及「系爭案請求項1之通孔性葉片123,123a,123b1,123b2」兩者比對認定為同一對應元件，顯有違誤。

(二)引證1之散熱層3設計無法達到引導出微型渦流之功效：

1.系爭案請求項1之波長轉換元件轉動時，通孔性葉片具有正面撞向空氣之表面，強制使氣流「通過」葉片通孔而引導出微型渦流。尤其請求項1已載明「通孔性葉片」，表示此葉片本身具有通孔性，即具有介於10ppi至500ppi之孔隙密度，或具有介於5%至95%之體積孔隙率，使得該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流。反之，引證1之散熱層3不論在外型或功能上均非葉片，且在波長轉換元件轉動時，該散熱層與空氣接觸之表面(如引證1之散熱層3底面與側面)只有切線方向之相對移動，並不具有任何正面撞向空氣之表面。

2.退步言，縱使引證1之散熱層3表面或許會牽引一些氣流(靠表面摩擦力)，但引證1並未揭露或教示氣流可「通過」散熱層3的氣孔，根本無法確定該散熱層是否可引導出微型渦流。更何況該散熱層於轉動時所產生之離心力，甚至還可能會「阻卻」空氣進入引證1之散熱層3中。由於引證1從未教示、原處分也從未證明引證1之散熱層3於轉動時，該散熱層3本身或特定位置處的組裝孔(實際應用時，組裝孔讓轉軸穿過，並與轉軸緊密銜接，並無空隙可供引導出微型渦流)得以引導出微型渦流，是原處分所稱屬無中生有。況且，引證1之散熱層3設計方向是減少氣孔率以提升導熱性能，明顯不利於氣體以任何方式進入散熱層3內，更遑論可以「讓氣體通過散熱層3的氣孔」而引導出微型渦流，且完全相反於系爭案請求項1之通孔性葉片設計。

(三)引證1揭露內容具有反向教示，系爭案所屬技術領域中具有通常知識者無法由引證1來推知系爭案請求項1之技術特徵：

1.引證1明確指出散熱層3之氣孔率越小(即孔隙越少)，導熱效果越好。換言之，引證1之散熱層3設計方向是減少氣孔率以提升導熱性能，完全相反於系爭案請求項1之通孔性葉片設計。則所屬技術領域中具有通常知識者可知引證1揭露「減少氣孔率」為提升導熱性能的必須條件。因此，引證1確實

具反向教示，顯示欲提升導熱性能必須以減少氣孔率之方式為之，乃熟知該領域人士必然的思考方向，並無法由引證1之內容來推知系爭案請求項1之技術特徵。

2.惟原處分及訴願決定忽略引證1具有反向教示，僅以引證1之散熱層有氣孔即可帶動氣流產生散熱效果，認所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證1之技術內容，能輕易完成系爭案請求項1之整體技術特徵(即通孔性葉片引導出微型渦流)並達成相同功效，而認定系爭案不具進步性，顯為違反進步性審查注意事項之後見之明，並不可採。

(四)原處分不當曲解引證1組裝孔之功能：

引證1波長轉換構件80用以與驅動其轉動之轉軸(例如馬達驅動軸)所裝配之「組裝孔」，顧名思義，所屬技術領域中具有通常知識者應可理解其功能即為讓轉軸穿過，並與轉軸緊密銜接。由於引證1並未明確揭露、教示組裝孔具有散熱的功能(設若引證1的組裝孔具有明顯積極的散熱功能，則有害於引證1之散熱層3設計方向是減少氣孔率以提升導熱性能)，原處分竟認無法排除該些許氣流有機會通過該裝配的「組裝孔」達到散熱之目的，逕認「組裝孔」具有使氣流通過之散熱功能，完全違背所屬技術領域中具有通常知識者對於「組裝孔」所提供功能之通常知識。因此，原處分據此認定引證1之「組裝孔」相當於系爭案請求項1之「通孔」，有明顯違誤。

(五)聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.被告應就第109128366號「波長轉換元件及光源模組」發明專利申請案，作成准予專利之審定。

三、被告答辯及聲明：

(一)將引證1之散熱層3比對為系爭案請求項1之通孔性葉片，並無違誤：

經比對引證1圖2記載之波長轉換元件(20)與系爭案之波長轉換元件(圖3)之剖面視圖，可發現兩者之外觀均相同。另由

系爭案說明書第[0024]段記載「通孔性葉片123的材料包含金屬、陶瓷以及玻璃中之一者」，而引證1亦記載散熱層之材料為陶瓷，故系爭案與引證1所使用之材料皆可為陶瓷，兩者相同。又由系爭案說明書第[0025]段末3行「通孔性葉片123的整體幾何形狀可以…形成葉片形狀或不為葉片形狀」之記載，可知系爭案通孔性葉片之「葉片」係可不以外觀形狀為其技術特徵。況系爭案請求項1並未對「葉片」之技術特徵有進一步界定，因此，原處分將引證1之元件3(散熱層)比對為請求項1之通孔性葉片(123)，並無違誤。

(二)引證1之散熱層3不論在外型或功能上，應可比對為系爭案所請利用「對流」方式產生氣流的「葉片」：

如原告主張微型渦流係由「通孔」產生，而引證1亦有揭示該元件3係為一具有「通孔」之元件(見說明書第11頁第15至19行「緻密陶瓷層之氣孔率…」)，引證1記載之「氣孔率」，與系爭案請求項1之「孔隙率」相當，故所屬技術領域具有通常知識者可以合理推知該元件3在波長轉換元件作動時，應當合理預期可以產生微型渦流。再者，引證1已揭示波長轉換機構係藉由螢光體層來對於光源進行波長轉換，故所屬技術領域具有通常知識者，當可理解此散熱層在轉換機構作動伴隨著旋轉時(見說明書第16頁第20行，波長轉換元件高速旋轉…)，會在散熱層產生氣流，且原告亦肯認引證1之散熱層3表面或許會牽引一些氣流，因此引證1散熱層3之通孔在波長轉換元件作動時產生微形渦流係可預期。執此，原處分將引證1的散熱層3不論在外型或功能上，應可比對為系爭案所請利用「對流」方式產生氣流的「葉片」，並無違誤。

(三)引證1之「組裝孔」相當於系爭案請求項1之「通孔」：

系爭案再審查階段提出修正請求項1：「…其中該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過…」，由於該請求項1對於通孔性葉片之「通孔」來源並無進一步界定，因此，引證1除葉片本身之「氣孔」(見說明書第11頁第15至19

行)外，裝配的「組裝孔」亦可該當於請求項1之「通孔」。另對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，當波長轉換機構在轉換機構旋轉時(見引證1說明書第16頁第20行)，所產生之氣流除可以通過葉片本身之「氣孔」外，亦無法排除該些許氣流有機會通過該裝配的「組裝孔」，而可達到散熱的目的，故原處分就此認定，並無違誤。

(四)聲明：原告之訴駁回。

四、本案爭點：

(一)引證1是否足以證明系爭案請求項1至4、6、9不具進步性？

(二)引證1、2之組合是否足以證明系爭案請求項5、10不具進步性？

(三)引證1、3之組合是否足以證明系爭案請求項7、8不具進步性？

(四)引證1、3、4之組合是否足以證明系爭案請求項11不具進步性？

五、本院判斷：

(一)應適用之法令：

1.按系爭案申請日為109年8月20日，再審查核駁審定日為111年11月9日，本件於112年12月7日言詞辯論終結，故系爭案是否符合專利要件，應以108年5月1日修正公布、108年11月1日施行之專利法(下稱核駁時專利法)為斷。

2.按「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」核駁時專利法第47條第1項定有明文。

(二)系爭案之申請專利範圍：

1.系爭案主要圖式：如附圖所示。

2.申請專利範圍：

申請專利範圍共11項（111年8月9日修正版），其中第1、11項為獨立項，其餘均為附屬項，內容如下：

⑴請求項1：一種波長轉換元件，包括：一基板，配置以基於一軸線轉動；一螢光粉層，設置於該基板上；以及一通

孔性葉片，設置於該基板上，並具有介於10ppi至500ppi之孔隙密度，或具有介於5%至95%之體積孔隙率，其中該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流。

⑵請求項2：如請求項1所述之波長轉換元件，其中該螢光粉層與該通孔性葉片分別位於該基板的相反兩側。

⑶請求項3：如請求項2所述之波長轉換元件，其中該螢光粉層與該通孔性葉片分別投影至該基板的正投影係至少部分重疊。

⑷請求項4：如請求項1所述之波長轉換元件，其中該螢光粉層與該通孔性葉片位於該基板的同一側。

⑸請求項5：如請求項1所述之波長轉換元件，進一步包含兩個該通孔性葉片，且該些通孔性葉片分別位於該基板的相反兩側。

⑹請求項6：如請求項1所述之波長轉換元件，其中該通孔性葉片的材料包含金屬、陶瓷以及玻璃中之至少一者。

⑺請求項7：如請求項1所述之波長轉換元件，其中該基板包含一金屬材料，且該金屬材料包含Al、Ag、Cu、Fe以及Mo中之至少一者。

⑻請求項8：如請求項1所述之波長轉換元件，其中該基板包含一陶瓷材料，且該陶瓷材料包含AIN、BN、SiC或Al_2O_3。

⑼請求項9：如請求項1所述之波長轉換元件，其中該基板包含一半導體材料，且該半導體材料包含Si、Ge、GaAs、InP、GaN、InAs、ZnSe、ZnS或InSe。

⑽請求項10：如請求項1所述之波長轉換元件，其中該基板的材料包含玻璃、石英、藍寶石或CaF_2。

⑾請求項11：一種光源模組，包含：一光源，配置以發射光線；一如請求項1至10任一所述之波長轉換元件，配置以接收該光線；以及一驅動單元，銜接該波長轉換元件，並配置以驅動該波長轉換元件基於該軸線轉動。

(三)核駁系爭案之引證：

附表所示引證1至4（主要圖式如附圖）之公開或公告日，皆早於系爭案之申請日109年8月20日，故皆可作為認定系爭案是否不具進步性之證據。

(四)引證1不足以證明系爭案請求項1至4、6、9不具進步性：

1.發明專利進步性之審查，係以先前技術為基礎判斷專利申請是否具有進步性。專利之發明或創作與先前技術之差異比較，重在申請專利案是否容易達成，應就申請案之發明或創作為整體（as a whole）判斷，並非僅就申請案之發明或創作之各個構成要件，逐一與先前技術比對而已，並應就申請專利範圍之每項請求項所載發明或創作整體為判斷，審視其是否所屬技術領域中具有通常知識或熟悉該項技術者（a person having ordinarily knowledge in the artbased on the prior art），以先前技術所能輕易完成者，雖得以一份或多份引證文件組合以為判斷，惟其組合，仍應以熟悉該項技術者於申請時所能輕易完成者為限，否則即難認不具進步性。

2.引證1之「散熱層」、「組裝孔」均無法對應於系爭案請求項1之「通孔性葉片」，並未揭露其「在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」技術特徵：

⑴依系爭案請求項1後段所載「其中該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之技術特徵，以及系爭案說明書第[0016]段記載「當驅動單元驅動基板轉動時，整體幾何形狀得以產生擾流，且通孔性葉片的通孔同時引導出微型渦流」、說明書第[0017]段記載「係於波長轉換元件中，設置於基板上的葉片的局部區域具有渦流產生功能。除了整體葉片幾何形狀的擾流機制，葉片材料或機構設計可再引導微型渦流效應，加速提升投影裝置整體內部腔體氣擾流作用。」內容可知，系爭案請求項1所稱「通孔性葉片」之「通孔」是被特別配置來引導出微型渦流，藉由熱對流方式以增加散熱效率，而

具有「在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之界定功能。

⑵由引證1說明書第3頁第10至13行記載「螢光體層所產生之熱傳遞至第1多孔質陶瓷層，但由於第1多孔質陶瓷層存在大量氣孔，故而存在導熱性不充分之情形。於此種情形時，若採用上述構成（即於本發明之波長轉換構件中，較佳為於第1多孔質陶瓷層之與形成有螢光體層之主面為相反側之主面形成有散熱層），則於螢光體層產生且傳導至第1陶瓷層之熱容易通過散熱層釋放至外部。因此，可進一步抑制螢光體層中之發熱」（卷第167頁），及引證1說明書第11頁第14至18行記載「作為散熱層3，例如可列舉緻密質陶瓷層。緻密質陶瓷層之氣孔率未達20體積%，較佳為15體積%以下，尤佳為10體積%以下。若緻密質陶瓷層之氣孔率過高，則熱導率降低而散熱性容易降低」（卷第175頁）內容可知，引證1所採取散熱層（如緻密質陶瓷層）係以「熱傳導」方式來提升散熱的效率，且引證1揭示為增加導走第1多孔陶瓷層從螢光體層所吸收過來的熱之效率，散熱層之氣孔率應愈低愈好。對照系爭案則是運用「熱對流」方式藉由微型渦流來提升散熱效率，堪認引證1「散熱層」材料（如緻密質陶瓷層）本身所具有之「氣孔」，與系爭案所稱「通孔性葉片」裡特別被配置用來產生微型渦流之「通孔」，兩者在成因及目的上皆不相同，故引證1之散熱層「氣孔」並不像系爭案「通孔性葉片」之「通孔」，具有「在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之功能。因此，系爭案所屬技術領域中具有通常知識者，無法直接藉由引證1「散熱層」所揭露內容得知系爭案請求項1之「通孔性葉片」，並未揭露系爭案請求項1之「通孔性葉片」以及「該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之技術特徵。

⑶被告雖辯以系爭案與引證1所使用之材料皆可為陶瓷，系爭案「通孔性葉片」之整體形狀可為葉片形狀或不為葉片形狀，並未對外觀為進一步界定，故可將引證1之散熱層3對應為系爭案請求項1之通孔性葉片云云。惟查，系爭案說明書第[0025]段固記載「須說明的是，通孔性葉片123的整體幾何形狀可以經由裁切、排列或拼湊等方式形成葉片形狀或不為葉片形狀，例如複數條狀的散射形排列方式」，且從系爭案第1至3圖可見，所謂「通孔性葉片」一具體實例為包含複數條狀在基板底面上散射形排列之結構。然前述內容僅在說明「通孔性葉片」之外觀形狀，不限於葉片形狀而可有多種選擇，並不妨礙系爭案所屬技術領域中具通常知識者對於系爭案請求項1之「通孔性葉片」係用於讓氣流通過並引導出微型渦流，以增加散熱效率之功能性界定，故被告所辯即非可採。

⑷另引證1第8圖所揭露之「組裝孔」（卷第192頁），系爭案所屬技術領域中具通常知識者，應可理解其功能為讓馬達驅動軸穿過，並讓波長轉換構件與驅動軸緊密銜接，以帶動波長轉換構件之旋轉，並非具有達成使氣流通過並散熱之功能。又由於引證1未明確揭露或教示「組裝孔」具有散熱的功能，且倘該組裝孔具有明顯積極的散熱功能，顯有害於引證1之散熱層設計方向是減少氣孔率以提升熱傳導之效率。故引證1之「組裝孔」亦無法對應於系爭案請求項1之「通孔性葉片」及「該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之技術特徵。

3.系爭案請求項1之「通孔性葉片」及「在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之技術特徵，並非該發明所屬技術領域中具通常知識者依引證1所能輕易完成：

⑴系爭案請求項1「通孔性葉片」之「通孔」是被特別配置來引導出微型渦流，以增加散熱效率，已如前述；又引證1說明書第11頁第14至18行記載「作為散熱層3，例如可列

舉緻密質陶瓷層。緻密質陶瓷層之氣孔率未達20體積%，較佳為15體積%以下，尤佳為10體積%以下。若緻密質陶瓷層之氣孔率過高，則熱導率降低而散熱性容易降低」，可知引證1揭示採取「氣孔率低」之緻密質陶瓷層，作為熱傳導方式來提升散熱的效率。雖然引證1說明書第6頁倒數第3段記載「第1多孔質陶瓷層1之氣孔率為20體積%以上，較佳為30體積%以上，尤佳為40體積%以上」內容，然其說明僅為引證1關於「第1多孔質陶瓷層1」之描述，並非「散熱層3」之描述，且該段亦有記載「若第1多孔質陶瓷層1之氣孔率過高，則機械強度降低或者熱導率降低而不易將螢光體層2所產生之熱釋放至外部」等語，可知依引證1所揭示技術內容，仍是採用熱傳導方式來提升散熱的效率。因此，系爭案所屬技術領域中具有通常知識者，在看到引證1所揭示「氣孔率過高，則熱導率降低」相關內容後，為達到增加散熱效率之目的，應會採取「氣孔率低」之緻密質陶瓷層或其他材料作為傳導散熱之方式，並無法輕易地聯想到將氣孔率愈低愈好之「散熱層」，進一步簡單變更或修飾成運用熱對流方式來提升散熱的效率即採用具有通孔讓氣流通過之「通孔性葉片」，而輕易完成系爭案請求項1所請發明。

⑵被告雖以引證1所記載「氣孔率」與系爭案請求項1之「孔隙率」相當，所屬技術領域具有通常知識者可以合理預期該「散熱層」在波長轉換元件作動時可產生微型渦流，且原告亦肯認引證1之散熱層表面或許會牽引一些氣流等等。引證1就作為散熱層之記載雖有提及「氣孔率」，惟係說明緻密質陶瓷層之氣孔率未達20體積%，較佳為15體積%以下，尤佳為10體積%以下；若氣孔率過高，則熱導率降低而散熱性容易降低等語，顯係強調以氣孔率較低之散熱層透過熱傳導方式來提升散熱效率。引證1之波長轉換構件於轉動運作時，在氣孔率過低或不足的情況下，其所揭露之「散熱層」即不必然會有讓氣流通過氣孔以產生微

型渦流之現象，並未實質隱含引證1之「氣孔」具有「在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之功能，而無法推知「散熱層」在波長轉換元件作動時可產生微型渦流之技術特徵，故被告執此認為具有氣孔之散熱層即可合理預期會產生「微型渦流」之存在，尚屬無據。

⑶綜上，系爭案所屬技術領域中具有通常知識者，並無法輕易地將引證1所揭露之「散熱層」簡單修飾或變更成系爭案請求項1之「通孔性葉片」，即非該發明所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成，難認不具有進步性。

4.又引證1並未揭露系爭案請求項1之「通孔性葉片」及「該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之技術特徵，業如前述。而系爭案請求項2至4、6、9，係直接或間接依附於請求項1之附屬項，均包含請求項1之所有技術特徵並為進一步界定，既然引證1並不足以證明系爭案請求項1不具進步性，自亦不足以證明系爭案請求項2至4、6、9不具進步性。

(五)引證1、2之組合無法證明系爭案請求項5、10不具進步性：

1.引證1並未揭露系爭案請求項1「通孔性葉片」及「該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之技術特徵，且非該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，已如前述。

2.依引證2摘要記載「螢光輪，包含具有螢光層之第一表面，與該第一表面相對之第二表面，用來從該第一表面及該第二表面投射之第一扇葉，用來從該第二表面傳輸空氣至該第一表面之通道。在旋轉該螢光輪時，該第一扇葉用來藉由該通道從該第一表面之一側傳輸空氣至該第二表面之一側」，可知引證2已揭露由扇葉從一側傳輸空氣至另一側，惟並未揭露引證1所未揭露之「通孔性葉片」及「該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之技術特徵。是以，引證1、2之組合並無法證明系爭案請求項1不具進步性。

3.又系爭案請求項5、10，係直接或間接依附於請求項1之附屬項，包含請求項1之所有技術特徵並為進一步界定，既然引證1、2之組合不足以證明系爭案請求項1不具進步性，該組合亦不足以證明系爭案請求項5、10不具進步性。

(六)引證1、3之組合無法證明系爭案請求項7、8不具進步性：

1.引證1並未揭露系爭案請求項1「通孔性葉片」及「該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之技術特徵，且非該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，已如前述。

2.依引證3摘要記載「一種具有降溫結構基板的波長轉換裝置。包括基板，設置在基板同一面或不同面的螢光粉色輪片層和氣流擾動結構。本發明通過設置氣流擾動結構，在驅動裝置驅動該發光裝置高速旋轉時，大大增強了基板表面空氣對流，從而提高了基板向外界散熱的能力；進一步的本發明設置散熱基板，通過熱傳導和對流的雙層散熱方式，進一步提高了散熱能力，從而確保波長轉換材料的效率」（卷第253頁），可知引證3雖有揭露設置在基板的氣流擾動結構，惟並未揭露引證1所未揭露之「通孔性葉片」及「該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之技術特徵。是以，引證1、3之組合並無法證明系爭案請求項1不具進步性。

3.又系爭案請求項7、8，係直接或間接依附於系爭案請求項1之附屬項，包含請求項1之所有技術特徵並為進一步界定，既然引證1、3之組合不足以證明系爭案請求項1不具進步性，該組合亦不足以證明系爭案請求項7、8不具進步性。

(七)引證1、3、4之組合無法證明系爭案請求項11不具進步性：

1.引證1、3之組合並無法證明系爭案請求項1不具進步性，已如前述。

2.依引證4摘要記載「一種可抑制螢光體層被過度加熱之波長轉換構件及使用其之發光裝置。本發明之波長轉換構件之特徵在於具備：散熱基板；螢光體層，其設置於散熱基板之

上；及接合材料層，其設置於散熱基板與螢光體層之間；且接合材料層具有導熱性多孔體與接合材料，且於導熱性多孔體中含浸有接合材料」（卷第267頁），可知引證4雖有揭露藉由散熱基板及具有導熱性多孔體之接合材料層來散熱，惟並未揭露引證1、3所未揭露之「通孔性葉片」及「該通孔性葉片的通孔配置以在該基板轉動時讓氣流通過，以引導出微型渦流」之技術特徵。是以，引證1、3、4之組合並無法證明系爭案請求項1不具進步性。

3. 又引證1、3、4之組合不足以證明系爭案請求項1不具進步性，則該組合亦不足以證明附屬於請求項1之系爭案請求項2至10不具進步性。而系爭案請求項11，係引用系爭案請求項1至10任一所述之請求項，即包含請求項1至10之所有技術特徵，是以引證1、3、4之組合亦不足以證明系爭案請求項11不具進步性。

六、綜上所述，引證1不足以證明系爭案請求項1至4、6、9不具進步性；引證1、2之組合不足以證明系爭案請求項5、10不具進步性；引證1、3之組合不足以證明系爭案請求項7、8不具進步性；引證1、3、4之組合不足以證明系爭案請求項11不具進步性，是以系爭案請求項1至11並未違反核駁時專利法第22條第2項規定，且無其他不准專利之事由，此經被告陳明（卷第325至326頁），依同法第47條第1項規定即應核予專利。故被告以系爭案申請違反同法第22條第2項之規定，為不予專利審定之原處分，於法即有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤。從而，原告訴請如主文所示，為有理由，應予准許。

七、本件判決基礎已經明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的必要。

八、結論：本件原告之訴為有理由，爰依修正前智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段、第200條第3款，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　12　　月　　29　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

法　官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所　需　要　件
㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
㈡非律師具有右列情形之	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。

一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　113　　年　　1　　月　　5　　日

書記官　蔣淑君

附表：

系爭案與引證	所在頁碼	備註
系爭專利民國109年8月20日申請書、111年8月9日修正申請專利範圍內容	申請卷第1至13、51至52頁	
西元2016年11月1日我國第201638053公開號「波長轉換構件及使用其之發光裝置」專利案	本院卷第161至195頁	(引證1)
西元2019年3月28日美國第2019/0094671公開號「PHOSPHOR WHEEL, PHOSPHOR WHEEL DEVICE INCLUDING THE SAME, LIGHT CONVERSION DEVICE, AND PROJECTION DISPLAY APPARATUS」專利案	本院卷第197至252頁	(引證2)
西元2015年5月13日中國大陸第104614926公開號「一种具	本院卷第253至266頁	(引證3)

有降温结构基板的波长转换装置和发光装置」專利案		
西元2019年2月1日我國第201906195公開號「波長轉換構件及發光裝置」專利案	本院卷第267至291頁	（引證4）